



## P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法

文献类型: 专利

.....

**作者** 陶汝华<sup>1</sup>; 方晓东<sup>1</sup>; 邓赞红<sup>1</sup>; 邓赞红<sup>1</sup>

**发表日期** 2008

**专利国别** 中国

**专利号** 101215702

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所

**公开日期** 2013-01-18

**申请日期** 2007

**专利申请号** 200710192050.4

**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9984>]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 陶汝华,方晓东,邓赞红,等. P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法, P型铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备方法. 101215702. 2008-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览  
**210**

下载  
**71**

收藏  
**0**

其他版本